# HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHRANSTALT HOLLABRUNN

# Höhere Abteilung für Elektronik – Technische Informatik

| Klasse / Jahrgang: 3BHELI           | Gruppe: 2 / a                                | Übungsleiter: <b>Prof. Dum</b> |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Übungsnummer: V/3                   | Übungstitel: Transistor - Kleinsignalbetrieb |                                |  |
| Datum der Übung: <b>11.03.2004</b>  | Teilnehmer: Glaßner, Hagmann, Kitzler, Weiß  |                                |  |
| Datum der Abgabe: <b>25.03.2004</b> | Schriftführer: Hagmann                       | Unterschrift:                  |  |

|                    | Beurteilung |
|--------------------|-------------|
| Aufgabenstellung   |             |
| Dokumentation      |             |
| Messschaltungen    |             |
| Messtabellen       |             |
| Berechnungen       |             |
| Programmlistings   |             |
| Auswertung         |             |
| Diagramme          |             |
| Berechnungen       |             |
| Simulationen       |             |
| Schlussfolgerungen |             |
| Kommentare         |             |
| Inventarliste      |             |
| Messprotokoll      |             |
| Form               |             |
| Summe              | <br>        |

# **ALLGEMEINER TEIL**

Titel der Übung: Transistor - Kleinsignalbetrieb

Übungsnummer: Übungsplatz: 8

Datum der Übung: 11.3.2004 Klasse: 3 BHELI

Schriftführer: Andreas Hagmann Übungsteilnehmer: Sebastian Glaßner

Andreas Hagmann Michael Kitzler Bernhard Weiß

# **INHALTSVERZEICHNIS**

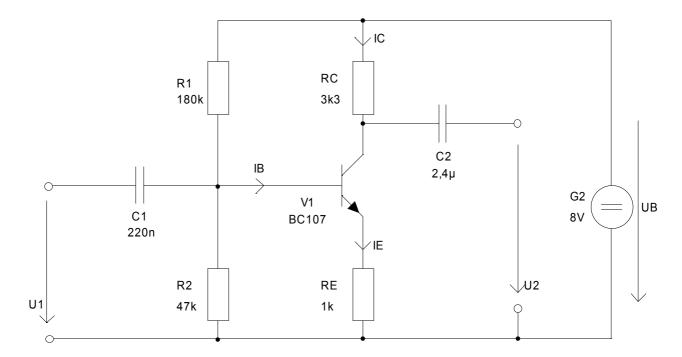
| Allgemeiner Teil                                | . 2 |
|---|-----|
| Inhaltsverzeichnis                              | . 2 |
| 1. Aufgabenstellung                             | . 3 |
| 2. Schaltung                                    |     |
| 3. Dimensionierung                              |     |
| 4. Überprüfung des Arbeitspunktes               | . 4 |
| 4.1. Messung                                    |     |
| 4.2. Erkenntnis                                 |     |
| 5.Messung der Verstärkung                       | . 5 |
| 5.1. Messung                                    |     |
| 5.2. Simulation                                 | . 5 |
| 5.3. Erkenntnis                                 | . 6 |
| 6. Ermitteln der maximalen Eingangsspannung     | . 6 |
| 6.1. Messung                                    |     |
| 6.2. Simulation                                 |     |
| 6.3. Erkenntnis                                 | . 6 |
| 7. Bestimmung der Grenzfrequenz                 | . 6 |
| 7.1. Messung                                    | . 6 |
| 7.2. Simulation                                 |     |
| 7.3. Erkenntnis                                 | . 7 |
| 8. Eingangs- und Ausgangswiderstand             | . 7 |
| 8.1. Messung                                    |     |
| 8.2. Eingangswiderstand bei Leerlauf am Ausgang | . 9 |
| 8.3. Ausgangswiderstand                         |     |
| 8.6. Erkenntnis                                 | . 9 |
| Anhang  |     |
| Messprotokoll                                   |     |

Inventarliste

# 1. AUFGABENSTELLUNG

Bei dieser Übung sollten wir einen einstufigen Kleinsignalverstärker in Form einer Emitterschaltung (= Emitter des Transistors ist weder Eingang noch Ausgang) dimensionieren und auf einem Steckbrett aufbauen. Anschließend sollten wir den Arbeitspunkt durch Messen überprüfen, seine Verstärkung messen, die Grenzfrequenzen messen und den differenziellen Eingangs und Ausgangswiderstand bestimmen.

# 2. SCHALTUNG



U1... Eingangsspannung U2... Ausgangsspannung

IC... Kollektorstrom

IB... Basisstrom

IE... Emitterstrom

**UB...** Betriebsspannung

Zur Einstellung der Betriebsspannung ( $U_B$ ) wurde ein Gleichspannungsnetzgerät (G2) verwendet.

# 3. DIMENSIONIERUNG

Zur Dimensionierung wurden uns folgende Daten gegeben:

U<sub>B</sub>=8V

 $I_C=1mA$ 

B=300

F<sub>au</sub>=200Hz

 $U_{BF}=0.7V$ 



U<sub>CE</sub> wurde mit U<sub>B</sub>/2 angenommen da somit eine maximale Aussteuerung erreicht wird.

$$\begin{split} \beta &= B \\ I_{C} &\approx I_{E} \\ I_{B} &= \frac{I_{C}}{B} = \frac{10^{-3}}{300} = \underline{3.3\mu A} \\ R_{1} &= \frac{U_{B} - U_{BE} - 1V}{11^{*}I_{B}} = \frac{8 - 0.7 - 1}{11^{*}3.3 * 10^{-6}} = \underline{173,55k\Omega} \Rightarrow E12 \Rightarrow \underline{180k\Omega} \\ R_{2} &= \frac{U_{BE} + 1V}{10^{*}I_{B}} = \frac{0.7 + 1}{10^{*}3.3 * 10^{-6}} = \underline{47k\Omega} \\ R_{C} &= \frac{U_{B}/2 - 1V}{I_{C}} = \frac{8/2 - 1}{10^{-3}} = \underline{3000\Omega} \Rightarrow E12 \Rightarrow \underline{3.3k\Omega} \\ R_{E} &= \frac{1V}{I_{C}} = \frac{1}{10^{-3}} = \underline{1k\Omega} \\ r_{e} &= \left(R_{1}^{-1} + R_{2}^{-1} + (\beta^{*}R_{E})^{-1}\right)^{-1} = \left(180000^{-1} + 47000^{-1} + (300 * 1000)^{-1}\right)^{-1} = \underline{33,15k\Omega} \\ r_{1} &= R_{C} &= \underline{3.3k\Omega} \\ C_{1} &= \frac{10}{2\pi^{*}f_{gu}^{*}} re = \frac{10}{2\pi^{*}200 * 33150} = \underline{240nF} \Rightarrow E12 \Rightarrow \underline{220nF} \\ C_{2} &= \frac{10}{2\pi^{*}f_{gu}^{*}} ra = \frac{10}{2\pi^{*}200 * 1000} = \underline{2.4\mu F} \Rightarrow E12 \Rightarrow \underline{2.2\mu F} \\ V_{0} &= -\frac{R_{C}}{R_{E}} = \frac{3300}{1000} = \underline{-3.3} \\ \end{split}$$

Die Werte der Kondensatoren wurden Aufgrund unklarer Beschriftung mit einem RLC – Meter (P2) nachgemessen.

# 4. ÜBERPRÜFUNG DES ARBEITSPUNKTES

#### 4.1. MESSUNG

Der Arbeitspunkt wurde mit einem Voltmeter (P3, Messbereich: Auto) und mit Hilfe einer Prüfspitze gemessen. Alle Spannungen wurden gegen Masse gemessen.

| Spannung gegen<br>Masse | Gemessen | Simuliert |
|-------------------------|----------|-----------|
| Betriebsspannung        | 8V       | 8V        |
| Kollektorspannung       | 4,99V    | 5,32V     |
| Basisspannung           | 1,55V    | 1,457V    |
| Emitterspannung         | 918mV    | 817mV     |

# 4.2. ERKENNTNIS

Die Messung stimmt im Allgemeinen mit den erwarteten Werten überein. Die Abweichungen von den gemessenen zu den simulierten Werten ergeben sich daher, dass für die Simulation das richtige Transistormodell nicht vorhanden war und somit nur ein ähnlicher Typ gewählt wurde, und dass die real aufgebaute Schaltung parasitäre Bauelemente enthielt.

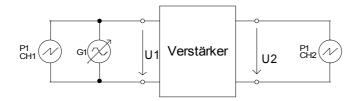
# 5.MESSUNG DER VERSTÄRKUNG

#### 5.1. MESSUNG

Die Verstärkung ist das Verhältnis von Ausgangsspannung (U2) zu Eingangsspannung (U1). Die beiden Spannungen wurden mit einem Oszilloskop (P1) dargestellt und gemessen.

Einstellungen am Funktionsgenerator (G1): Sinus, Spitzenspannung = 100mV, Frequenz = 1kHz

#### Messschaltung:



Am Ausgang wurde eine Spitzenspannung von 320mV gemessen.

$$V_0 = -\frac{U_2}{U_1} = \frac{320 * 10^{-3}}{100 * 10^{-3}} = \frac{-3.2}{100 * 10^{-3}}$$

Da diese Verstärkerschaltung das Signal invertiert ergibt sich eine Verstärkung von -3,2.

#### 5.2. SIMULATION

Bei der Simulation ergab sich mit gleichen Einstellungen für die Eingangsspannung wie oben am Ausgang eine Spitzenausgangsspannung von 327mV und daher eine Verstärkung von:

$$V_0 = -\frac{U_2}{U_1} = \frac{327 * 10^{-3}}{100 * 10^{-3}} = \frac{-3.27}{100}$$

Ein Diagramm von Eingangs- und Ausgangsspannung befindet sich im Anhang (Anhang 1, Zeitdiagramm von Eingangs- und Ausgangsspannung).

#### 5.3. ERKENNTNIS

Die Verstärkung wurde an der realen Schaltung nur einmal bei 1kHz gemessen. In der Simulation ist aber zu erkennen, dass sich die Verstärkung mit der Frequenz ändert. (Anhang 2, Verstärkung) Siehe auch Bestimmung der oberen- und unteren Grenzfrequenz.

Im Zeitdiagramm von Eingangs und Ausgangsspannung (Anhang 1) ist die Invertierung des Signals zu erkennen.

# 6. ERMITTELN DER MAXIMALEN EINGANGSSPANNUNG

#### 6.1. MESSUNG

Die maximale Eingangsspannung, ohne das am Ausgang Verzerrungen auftreten, wurde mit derselben Messschaltung wie in der oberen Aufgabe ermittelt. Es wurde die Spannung (U1) am Frequenzgenerator (G1) solange erhöht bis die Ausgangsspannung (U2) am Oszillostkop (P1) nicht mehr als reine Sinusschwingung zu erkennen war.

Dies geschah bei einer Eingangsspannung von: 1V Spitzenspannung.

#### 6.2. SIMULATION

Die maximale Eingangsspannung wurde auch durch eine Simulation ermittelt. Das Diagramm dieser Simulation befindet sich im Anhang (Anhang 3, Zeitdiagramm der Ausgangsspannung). Es ergab sich eine maximale Eingansspannung von 0,8V Spitze.

#### 6.3. ERKENNTNIS

Die Differenz der gemessenen Werte zu den simulierten ist auf die Ungenauigkeit beim Ablesen vom Oszilloskop und auf die unterschiedlichen Transistortypen zurückzuführen.

Wenn das Eingangssignal größer als 0,8V Spitze (laut Simulation) ist enthält das Ausgangssignal Oberwellen und am Oszilloskop kann man einen abgeschnitten Sinus erkennen (Anhang 3, Zeitdiagramm der Ausgangsspannung).

Die Oberwellen sind mit Hilfe einer Fourier Transformation zu erkennen: Anhang 4. In diesem Diagramm ist bei einer Eingangsspannung von 0,5V Spitze nur die Grundschwingung zu erkennen. Bei einer Eingangsspannung von 1,5V Spitze sind die Grundschwingung und mehrere Oberwellen zu sehen.

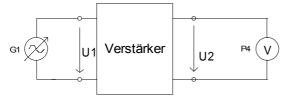
# 7. BESTIMMUNG DER GRENZFREQUENZ

## 7.1. MESSUNG

Die Grenzfrequenz ist die Frequenz bei der die Verstärkung um 3dB von ihrem maximalen Wert abnimmt.



Die Grenzfrequenz wurde mit einem speziellen Millivoltmeter (P4) mit einer dB-Skala gemessen.



Als Referenzpegel diente uns der Pegel bei 1kHz.

Danach wurde die Frequenz nach unten (untere Grenzfrequenz) und dann nach oben (obere Grenzfrequenz) am Funktionsgenerator solange verändert bis das Voltmeter -3dB anzeigte.

Untere Grenzfrequenz: 22Hz Obere Grenzfrequenz: 149kHz

#### 7.2. SIMULATION

Bei der Simulation wurde eine untere Grenzfrequenz von 23.96Hz abgelesen. Die obere Grenzfrequenz betrug 13,95MHz (Anhang 2, Verstärkung über der Frequenz).

# 7.3. ERKENNTNIS

Die untere Grenzfrequenz hängt von den Größen der Koppelkondensatoren ab. Bei der Dimensionierung wurde eine untere Grenzfrequenz von 200Hz vorgegeben. Dieser Wert wurde um zirka das 10-fache unterschritten, da zur Dimensionierung nur eine näherungsweise Formel verwendet wurde.

Die unter Grenzfrequenz stimmt auch mit der Simulation überein. Die Abweichungen ergeben sich wieder durch die Verwendung des anderen Transistormodells und dass die real aufgebaute Schaltung parasitäre Bauelemente enthielt.

Die obere Grenzfrequenz wird hauptsächlich vom Transistor bestimmt. Daher ergab sich in der Simulation durch den unterschiedlichen Transistortyp auch ein anderer Wert als in der aufgebauten Schaltung.

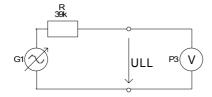
# **8. EINGANGS- UND AUSGANGSWIDERSTAND**

#### 8.1. MESSUNG

Zur Bestimmung der Eingangs- und Ausgangswiderstände wurde in Serie zum Generator ein Widerstand (R,  $39k\Omega$ ) geschaltet und es wurden folgende Messungen durchgeführt:

Alle Messungen wurden mit einem 1kHz Sinussignal durchgeführt.

## 1. Leerlaufspannung des Generators



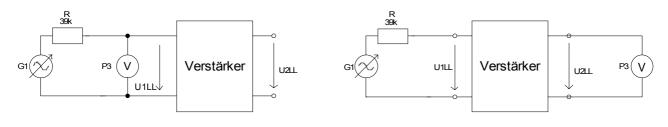
Die Leerlaufspannung (U<sub>LL</sub>) wurde mit einem Voltmeter (P3, Messbereich: Auto) gemessen.

U<sub>LLGENRATOR</sub>=282mV

#### 2. Eingangs und Ausgangsspannung des Verstärkers ohne Last

Messung der Eingangsspannung (U1)

Messung der Ausgangsspannung (U2)



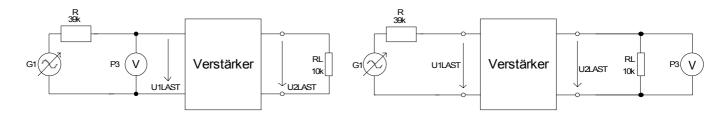
Die Spannungen wurden wieder mit einem Voltmeter (P3, Messbereich: Auto) gemessen.

 $U_{1LL}$ =130mV  $U_{2LL}$ =415mV

#### 3. Eingangs und Ausgangsspannung des Verstärkers mit 10kΩ Last

Messung der Eingangsspannung (U1)

Messung der Ausgangsspannung (U2)

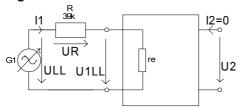


Die Spannungen wurden wieder mit einem Voltmeter (P3, Messbereich: Auto) gemessen.

 $U_{1LAST}$ =138mV  $U_{2LAST}$ =313mV

#### 8.2. EINGANGSWIDERSTAND BEI LEERLAUF AM AUSGANG

Zur Bestimmung des Eingangswiderstandes benötigt man die ersten beiden Messungen.

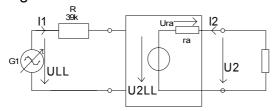


$$\begin{split} I_1 &= \frac{U_{LLGENERATOR} - U_{1LL}}{R} = \frac{282*10^{-3} - 130*10^{-3}}{39000} = \underline{\frac{3,897 \,\mu\text{A}}{1}} \\ r_e &= \frac{U_1}{I_4} = \frac{130*10^{-3}}{3.897*10^{-6}} = \underline{\frac{33,35k\Omega}{3000}} \end{split}$$

Der Innenwiderstand des Funktionsgenerators (G1) wurde aufgrund seines im Verhältnis zu dem in Serie geschalteten Widerstandes (R,  $39k\Omega$ ) sehr geringen Wertes ( $50\Omega$ ) vernachlässigt.

#### 8.3. AUSGANGSWIDERSTAND

Zur Berechnung des Ausgangswiderstandes benötigt man die letzten beiden Messungen.



$$\begin{split} I_2 &= -\frac{U_{2LAST}}{R_L} = -\frac{313*10^{-3}}{10000} = \underbrace{\frac{-31,3\mu}{A}}_{10000} \\ r_a &= \frac{U_{2LL} - U_{2LAST}}{-I_2} = \underbrace{\frac{415*10^{-3} - 313*10^{-3}}{31.3*10^{-6}}}_{31.3*10^{-6}} = \underbrace{\frac{3,26k\Omega}{31.3*10^{-6}}}_{10000} \end{split}$$

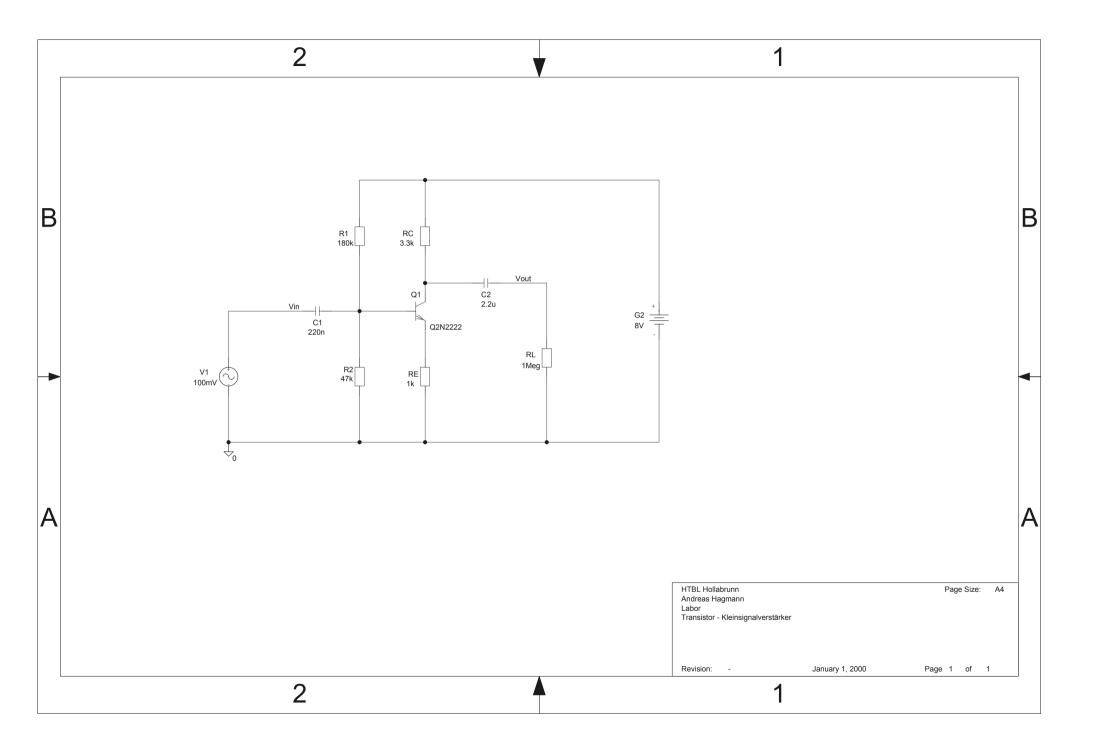
# 8.6. ERKENNTNIS

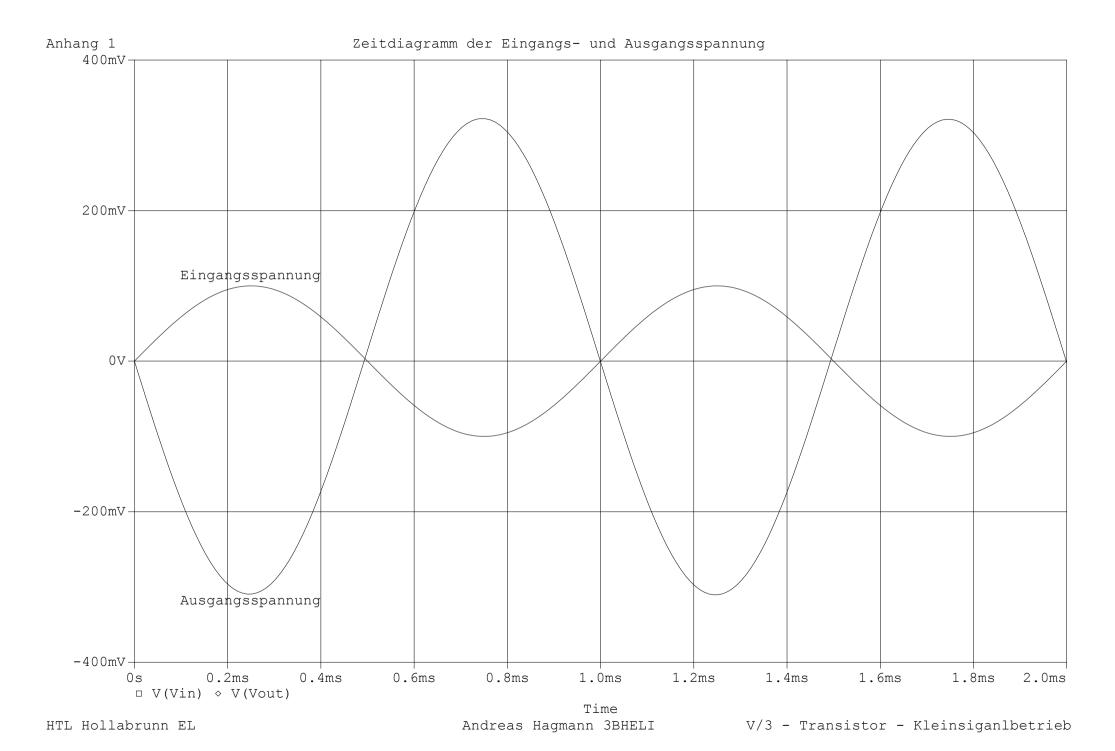
Werte bei einem Eingangssignal mit einer Frequenz von 1kHz:

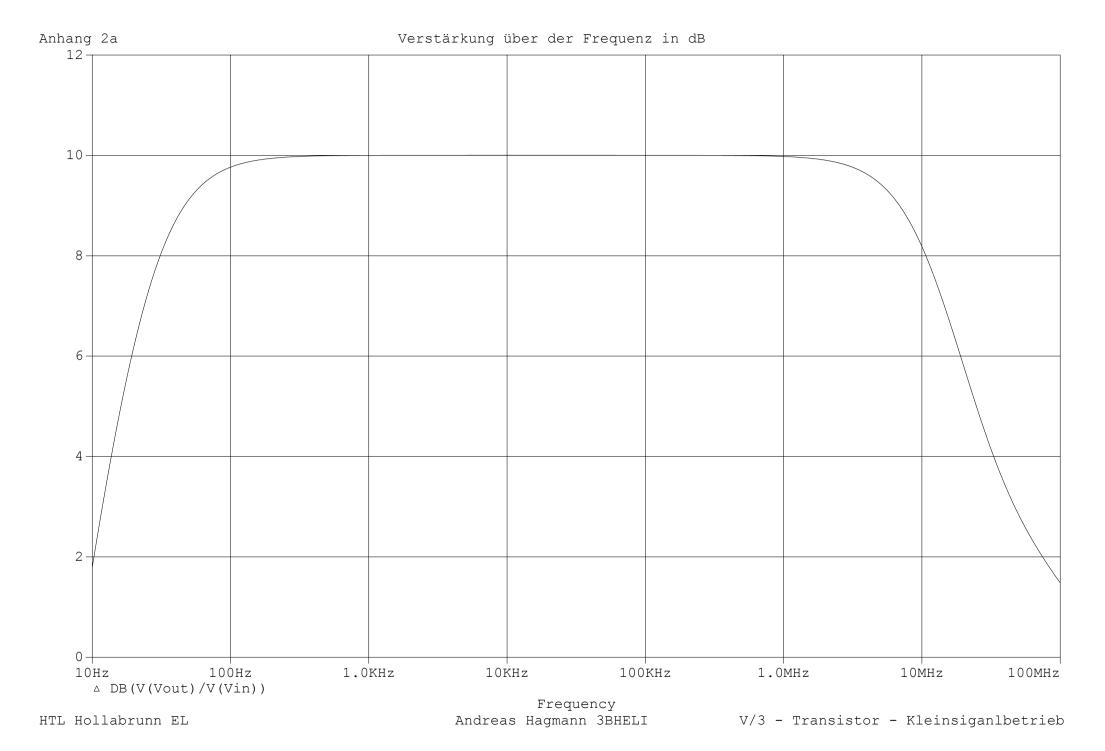
|                    | Gemessen        | Gerechnet | Simuliert |
|--------------------|-----------------|-----------|-----------|
| Eingangswiderstand | 33,35k $\Omega$ | 33,15kΩ   | 30,422kΩ  |
| Ausgangswiderstand | 3,26k $\Omega$  | 3,3kΩ     | 3,312kΩ   |

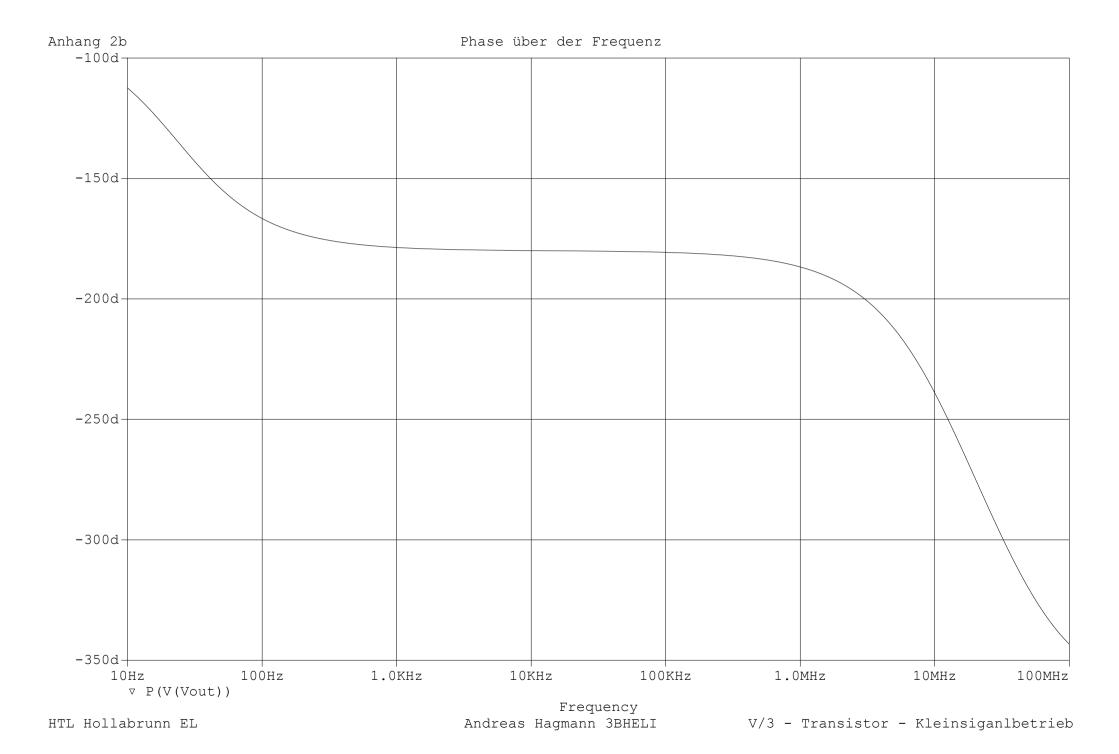
Die Abweichungen ergeben sich aus den parasitären Bauelementen in der real Aufgebauten Schaltung und dem anderen Transistortyp in der Simulation.

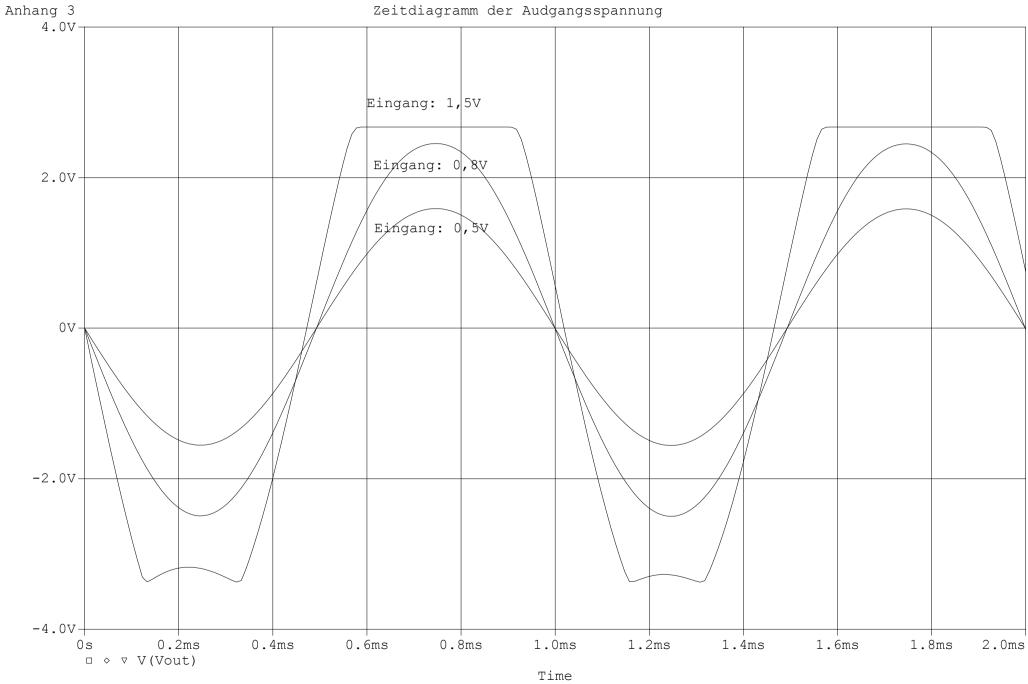
Der Eingangswiderstand und der Ausgangswiderstand wurden nur bei einem Eingangssignal mit einer Frequenz von 1kHz gemessen. In der Simulation wurde aber ersichtlich, dass diese Widerstände über die Frequenz nicht konstant sind. Der Eingangswiderstand (Anhang 5, Eingangswiderstand über die Frequenz) ist bei niederen Frequenzen wesentlich höher, fällt im Bereich von 500Hz – 30kHz auf einen konstanten Wert und wird bei höheren Frequenzen noch kleiner. Der Ausgangswiderstand (Anhang 6, Ausgangswiderstand über die Frequenz) verhält sich über die Frequenz so wie der Eingangswiderstand.







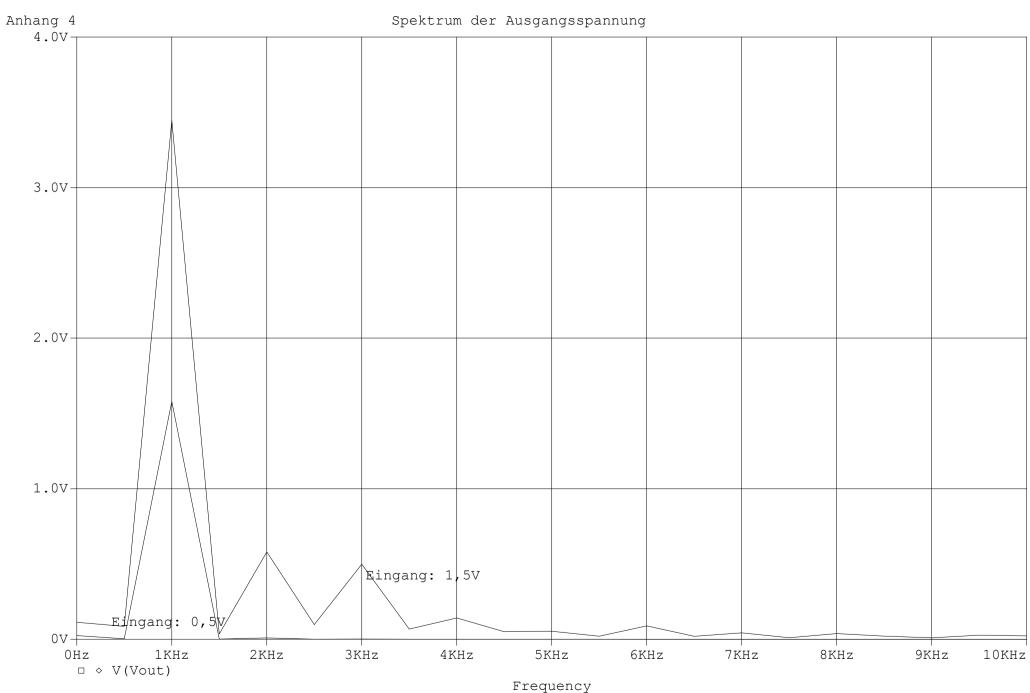




HTL Hollabrunn EL

Andreas Hagmann 3BHELI

V/3 - Transistor - Kleinsiganlbetrieb



Andreas Hagmann 3BHELI

V/3 - Transistor - Kleinsiganlbetrieb

